

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Văn Chương

2. Ngày tháng năm sinh: 10/11/1986; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): CH507, CT2-C2, Khu nhà ở Đài PSPT Mễ Trì, Tổ 1, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nguyễn Văn Chương, Bộ môn Vật liệu và CNVL, Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0981586598;

E-mail: chuong.vnguyen@lqdtu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 03,2016 đến tháng, năm 08,2021: Giảng viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Địa chỉ cơ quan: số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

Không có

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 18 tháng 06 năm 2012, số văn bằng: BCA 0580549, ngành: Khoa học vật liệu, chuyên ngành: Khoa học vật liệu

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia sông Đông, Liên bang Nga

- Được cấp bằng TS [5] ngày 12 tháng 11 năm 2015, số văn bằng: KND 013388, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý trạng thái ngưng tụ

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp miền Nam, Liên bang Nga

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS cơ sở: Học viện Kỹ thuật Quân sự

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Hướng nghiên cứu 1: Tính chất điện tử và truyền dẫn của vật liệu nanô graphene và hiệu ứng tiếp xúc kim loại – bán dẫn giữa graphene với vật liệu bán dẫn 2 chiều định hướng ứng dụng trong các thiết bị điện tử hiệu năng cao.

Hướng nghiên cứu 2: Cấu trúc, tính chất điện tử, và truyền dẫn của vật liệu 2 chiều và các đặc trưng tiếp xúc bán dẫn – bán dẫn của cấu trúc dị thể van der Waals giữa chúng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 cấp Nhà nước;

- Đã công bố (số lượng) 50 bài báo khoa học, trong đó 43 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giải thưởng nghiên cứu trẻ	Hội Vật lý lý thuyết	2017
2	Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba	Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	2017
3	Chiến sĩ thi đua	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018
4	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018
5	Giáo viên dạy tốt	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018
6	Chiến sĩ tiên tiến	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2020
7	Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2020

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

--	--	--	--

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Trong thời gian là giảng viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và các nhiệm vụ khác của giảng viên. Tôi thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, và các quy định của nhà trường. Tôi cố gắng và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý, chương trình giáo dục.
- Tôi luôn giữ gìn phẩm chất và uy tín của nhà giáo, cũng như tôn trọng, đối xử công bằng, và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học. Trong quá trình giảng dạy, tôi đặt học viên và sinh viên làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của người học. Tôi cũng cố gắng khuyến khích tính phản biện và coi trọng phản hồi của người học về các nội dung và phương pháp giảng dạy. Trong công tác và cuộc sống, tôi luôn giữ gìn các mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, cộng tác và hỗ trợ các đồng nghiệp trong công tác.
- Về chuyên môn, tôi cố gắng nâng cao trình độ, học hỏi, và mở rộng kiến thức. Tôi tham gia tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật các kiến thức mới về các học phần đảm nhiệm. Với nghiên cứu khoa học, tôi luôn đam mê và với cương vị là một giảng viên đại học, tôi coi đó là một công việc rất quan trọng. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức, tác phong khoa học, cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng khoa học.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số 5 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BS NT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1								
2	7/2016-6/2017				2	285		285/310/270
3	7/2017-6/2018			2		270		270/410/270
03 năm học cuối								
4	7/2018-6/2019			1		285		285/335/270
5	7/2019-6/2020					380		380/380/270
6	7/2020-6/2021				1	335		335/347/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Nga

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: Liên bang Nga; Từ năm 2006 đến năm 2012

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Liên bang Nga năm 2015

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC 600

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVC H/CK 2/BS NT	Chính	Phụ			
1	Vũ Thanh Tuyền		X	X		09/2017 đến 05/2018	Trường Đại học sư phạm Huế	2018
2	Nguyễn Phú Cường		X	X		09/2017 đến 05/2018	Trường Đại học sư phạm Huế	2018
3	Phan Thị Hằng		X	X		08/2018 đến 06/2019	Trường Đại học sư phạm Huế	2019

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phản biên	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản)
----	----------	----------------------------	------------------------------	------------	----------	-----------	--------------------------------------

						soạn (từ tran g ... đến tran g)	xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Магнетизм и транспортные свойства нанолент графена на полупроводниковых подложках	CK	Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia sông Đông, năm 2016	2	VC		1854/GCN-HV

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/ TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene trên các lớp đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài	CN	103.01-2016.07, cấp Nhà nước	28/04/2017 đến 28/04/2019	Ngày 25 tháng 01 năm 2019/Kết quả Đạt
2	Tính chất điện tử và truyền dẫn của một số vật liệu monochalcogenide, dichalcogenide và dị cấu trúc giữa chúng	TK	103.01-2017.309, cấp Nhà nước	01/08/2018 đến 01/08/2020	Ngày 25 tháng 01 năm 2021/Kết quả Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài	Số tác	Là tác	Tên tạp chí hoặc kỷ	Loại Tạp	Số lần	Tập, số,	Tháng
----	---------	--------	--------	---------------------	----------	--------	----------	-------

	báo/báo cáo KH	giả	giả chính	yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	chỉ quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	trang	, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Edge and substrate-induced bandgap in zigzag graphene nanoribbons on the hexagonal nitride boron 8-ZGNR/h-BN (0001	5	Có	AIP Advances/ ISSN: 2158-3226	Q2 - ISI IF: 1.548	8	3, 9, 092105-092113	09/2013
2	Краевые эффекты в двухслойных нанолентах графена типа зигзаг: Ab initio изучение методом функционала плотности	3	Không	Proceedings of the 16-th International meeting on Order, Disorder and Properties of Oxides, 7-12 September 2013, Rostov on Don, Russia/ISBN: 978-5-87872-726-6			1, N/A, 146-149	09/2013
3	Magnetism and transport properties of zigzag graphene nanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructures	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - ISI IF: 2.546	20	115, 5, 053708-053713	01/2014
4	Tuning the band structure, magnetic and transport properties of the zigzag graphene nanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructures by transverse electric field	4	Có	Journal of Chemical Physics/ ISSN: 0021-9606	Q1 - ISI IF: 3.488	28	141, 1, 014708-014715	07/2014

5	Переход полупроводник-полуметалл-металл в бислое нанолент графена на гексагонально м нитриде бора: эффект одноосной деформации	2	Có	Proceedings of the 17-th International meeting on Order, Disorder and Properties of Oxides, 5-10 September 2014, Rostov on Don, Russia/ISBN: 978-5-9905703-7-5			129-132	09/2014
6	Semiconductor-halfmetal-metal transition and magnetism of bilayer graphene nanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructure	4	Có	Solid State Communications/ISSN: 0038-1098	Q2 - ISI IF: 1.804	6	199, 1-10	12/2014
7	Tuning the electronic properties of armchair graphene nanoribbons by strain engineering	3	Có	Physica Scripta/ISSN: 1402-4896	Q2 - ISI IF: 2.487	3	90, 1, 015802-015808	01/2015
8	Substrate-induced band structure and electronic properties in graphene/Al ₂ O ₃ (0001) interface	5	Có	Surface Science/ISSN: 0039-6028	Q1 - ISI IF: 1.942	2	632, 111-117	02/2015
9	Modulation of the band structure in bilayer zigzag graphene nanoribbons on hexagonal boron nitride using the force	5	Có	Materials Chemistry and Physics/ISSN: 0254-0584	Q2 - ISI IF: 4.094	2	154, 78-83	03/2015

	and electric fields							
10	Effect of electric field on the electronic and magnetic properties of a graphene nanoribbon/aluminium nitride bilayer system	5	Có	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - ISI IF: 3.361	6	5, 61, 49308-49316	05/2015
11	Electric field and substrate-induced modulation of spin-polarized transport in graphene nanoribbons on A3B5 semiconductors	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - ISI IF: 2.546	6	117, 17, 174309-174316	05/2015
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
12	Modulation the Band Structure and Physical Properties of the Graphene Materials with Electric Field and Semiconductor Substrate	6	Có	Spinger Proceeding in Physics/ ISBN: 978-3-319-26322-9	- Scopus		175, 279-297	01/2016
13	Nghiên cứu các tính chất điện tử của cấu trúc dị thể graphene-Al ₂ O ₃	2	Có	Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học sư phạm Huế/ ISSN: 1859-1612			42, 2, 54-60	06/2017
14	Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài đến tính chất điện tử của hệ graphene/molybdenum disulfide	6	Có	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X/ ISBN: 978-604-95-0325-2			Quyển 1, 171-173	10/2017
15	Out-of-plane	6	Có	Superlattices and	Q2 - ISI IF:	11	112, 554-	10/201

	strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/antimonene heterostructure			Microstructures/ ISSN: 0749-6036	2.658		560	7
16	Tuning the Electronic Properties, Effective mass and carrier mobility of MoS ₂ monolayer by strain engineering: first-principle calculations	9	Có	Journal of Electronic Materials/ ISSN: 0361-5235	Q2 - ISI IF: 1.938	29	47, 1, 730-736	01/2018
17	First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS ₂ monolayer under applied out-plane strain	4	Có	Surface Science/ ISSN: 0039-6028	Q1 - ISI IF: 1.942	20	668, 23- 28	02/2018
18	Electric-field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/phosphorene heterostructure	4	Có	Vacuum/ ISSN: 0042-207X	Q2 - ISI IF: 3.627	16	149, 231- 237	03/2018
19	First-principles study of electronic properties of AB-stacked	6	Có	Indian Journal of Physics/ ISSN: 0973-1458	Q3 - ISI IF: 1.947	3	92, 4, 447-452	04/2018

	bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain							
20	Van der Waals graphene/g- GaSe heterostructure: tuning the electronic properties and Schottky barrier by interlayer coupling, biaxial strain, and electric gating	5	Có	Journal of Alloys and Compounds/ ISSN: 0925-8388	Q1 - ISI IF: 5.316	23	75, 765- 773	06/201 8
21	Interlayer coupling and electric field tunable electronic properties and Schottky barrier in a graphene/bilaye r-GaSe van der Waals heterostructure	4	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - ISI IF: 3.676	40	20, 26, 17899- 17908	06/201 8
22	First principles calculations of the geometric structures and electronic properties of van der Waals heterostructure based on graphene, hexagonal boron nitride and molybdenum diselenide	2	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - ISI IF: 3.315	10	88, 151- 157	09/201 8
23	First principles study of the	7	Có	Computational Materials Science/	Q1 - ISI IF: 3.3	25	153, 438- 444	10/201 8

	electronic properties and Schottky barrier in vertically stacked graphene on the Janus MoSeS under electric field			ISSN: 0927-0256				
24	Layered graphene/GaS van der Waals heterostructure: Controlling the electronic properties and Schottky barrier by vertical strain	7	Có	Applied Physics Letters/ ISSN: 0003-6951	Q1 - ISI <i>IF</i> : 3.791	112	113, 15, 171605 (5 trang)	10/2018
25	Modulation of electronic properties and Schottky barrier in the graphene/GaS heterostructure by electric gating	3	Có	Physica B: Condensed Matter/ ISSN: 0921-4526	Q2 - ISI <i>IF</i> : 2.436		555, 69-73	02/2019
26	Tailoring electronic properties and Schottky barrier in sandwich heterostructure based on graphene and tungsten diselenide	7	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - ISI <i>IF</i> : 3.315	8	94, 129-136	04/2019
27	Controlling electronic properties of PtS ₂ /InSe van der Waals heterostructure via external electric field and vertical strain	4	Có	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - ISI <i>IF</i> : 2.328	6	724, 1-7	06/2019

28	Electric field tunable electronic properties of P-ZnO and SiC-ZnO van der Waals heterostructures	5	Không	Computational Materials Science/ ISSN: 0927-0256	Q1 - ISI <i>IF</i> : 3.3	7	164, 166-170	06/2019
29	Computational understanding of electronic properties of graphene/PtS ₂ heterostructure under electric field	3	Có	Applied Physics A/ ISSN: 0947-8396	Q2 - ISI <i>IF</i> : 2.584	2	125, 8, 536-343	07/2019
30	Tailoring the structural and electronic properties of an SnSe ₂ /MoS ₂ van der Waals heterostructure with an electric field and the insertion of a graphene sheet	10	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - ISI <i>IF</i> : 3.676	15	21, 39, 22140-22148	09/2019
31	Strain and electric field engineering of electronic structures and Schottky contact of layered graphene/Ca(OH) ₂ heterostructure	7	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - ISI <i>IF</i> : 2.658	3	133, 106185-106192	09/2019
32	Strain and electric field engineering of band alignment in InSe/Ca(OH) ₂ heterostructure	7	Có	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - ISI <i>IF</i> : 2.328	4	732, 136649-136655	10/2019
33	Rashba spin splitting and photocatalytic	7	Có	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - ISI <i>IF</i> : 4.036	58	100, 18, 165425-165433	10/2019

	properties of GeC–MSSe (M = Mo, W) van der Waals heterostructures							
34	Graphene/WSe Te van der Waals heterostructure: Controllable electronic properties and Schottky barrier via interlayer coupling and electric field	8	Có	Applied Surface Science/ ISSN: 0169-4332	Q1 - ISI IF: 6.707	45	507, 145036-145045	03/2020
35	Electronic properties and enhanced photocatalytic performance of van der Waals heterostructures of ZnO and Janus transition metal dichalcogenides	8	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - ISI IF: 3.676	10	22, 10351-10359	04/2020
36	Graphene hetero-multilayer on layered platinum mineral Jacutingaite (Pt ₂ HgSe ₃): Van der Waals heterostructures with novel optoelectronic and thermoelectric performances	5	Không	Journal of Materials Chemistry A/ ISSN: 0959-9428	Q1 - ISI IF: 12.732	24	8, 13248-13260	05/2020
37	Electronic and optoelectronic properties of van der Waals heterostructure based on	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - ISI IF: 2.546	4	127, 24, 245302-9	06/2020

	graphene-like GaN, blue phosphorene, SiC, and ZnO: A first principles study							
38	Understanding the electronic properties, contact types and optical performances in graphene/InN heterostructure: Role of electric gating	9	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - ISI IF: 3.315	3	106, 107851-107858	06/2020
39	Interlayer coupling and electric field controllable Schottky barriers and contact types in graphene/PbI2 heterostructures	7	Có	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - ISI IF: 4.036	19	101, 23, 235419	06/2020
40	Electronic, optical and mechanical properties of graphene/MoS2 nanocomposite	5	Có	Journal of Science and Technique of Le Quy Don Technical University/ISSN: ISSN: 1859 - 0209			209, 5-16	07/2020
41	Electronic and photocatalytic performance of boron phosphide-blue phosphorene vdW heterostructures	7	Không	Applied Surface Science/ ISSN: 0169-4332	Q1 - ISI IF: 6.707	25	523, 146483	09/2020
42	A type-II GaSe/HfS2 van der Waals heterostructure as promising photocatalyst with high carrier mobility	4	Không	Applied Surface Science/ ISSN: 0169-4332	Q1 - ISI IF: 6.707	14	534, 147607 (11 trang)	12/2020

43	Vertical two-dimensional layered conjugated porous organic network structures of poly-benzimidazobenzophenanthroline (BBL): A first-principles study	4	Không	Applied Physics Letters/ ISSN: 0003-6951	Q1 - ISI IF: 3.791	7	117, 23, 233101-233105	12/2020
44	Study of the Elastic Properties of the Energetic Molecular Crystals Using Density Functionals with van der Waals Corrections	3	Có	ACS Omega/ISSN: 2470-1343	Q1 - ISI IF: 3.512		6, 1, 642–648	01/2021
45	Electric gating and interlayer coupling controllable electronic structure and Schottky contact of graphene/BiI ₃ van der Waals heterostructure	1	Có	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - ISI IF: 4.036	2	103, 11, 115429 (8 trang)	03/2021
46	Strain engineering of Janus ZrSSe and HfSSe monolayers and ZrSSe/HfSSe van der Waals heterostructure	6	Không	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - ISI IF: 2.328		776, 138689-138695	04/2021
47	Two-Dimensional Boron Phosphide/MoGe ₂ N ₄ van der	5	Có	Journal of Physical Chemistry Letters/ISSN: 1948-7185	Q1 - ISI IF: 6.475	1	12, 21, 5076–5084	05/2021

	Waal Heterostructure: A Promising Tunable Optoelectronic Material							
48	Ab initio prediction of semiconductivity in a novel two-dimensional Sb ₂ X ₃ (X= S, Se, Te) monolayers with orthorhombic structure	9	Không	Scientific Reports/ISSN 2045-2322	Q1 - ISI IF: 4.379	1	11, 1, 10366-10375	05/2021
49	Point defects in two-dimensional ZnSnN ₂ nanosheet: First-principles study on the electronic and magnetic properties	9	Không	Journal of Physical Chemistry C/ISSN: 1932-7455	Q1 - ISI IF: 4.126	1	125, 23, 13067–13075	05/2021
50	Prediction of the Structural and Electronic Properties of a Single Layer Graphene-like Two-dimensional Janus GaInSTe	3	Có	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics/ISSN: 2588-1124			37, 2, 93-99	06/2021

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 26 ([15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [37] [38] [39] [44] [45] [47])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó, số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự):

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự):

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 01 năm

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2022

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)